

**КТ624**

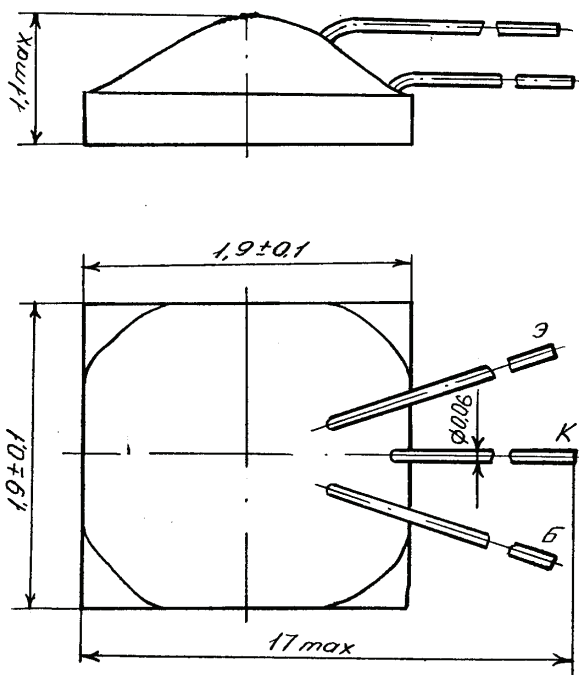
кремниевый биполярный  
эпитаксиально-планарный  
п-р-п транзистор

**Назначение**

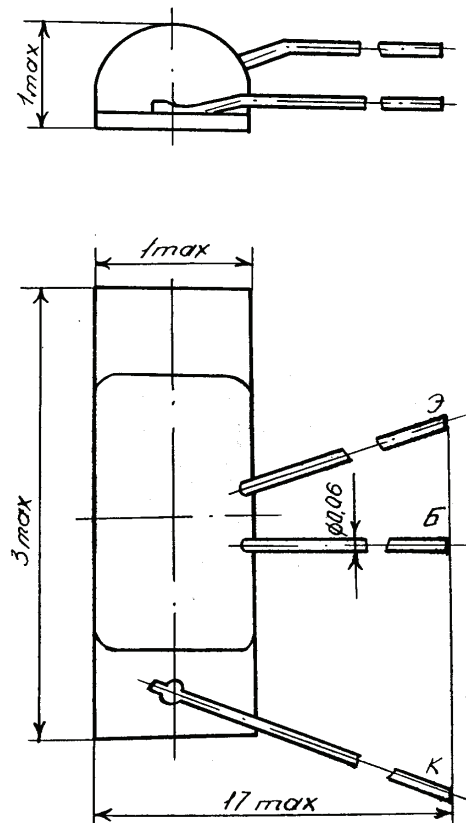
Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы КТ624А-2, КТ624АМ-2 предназначены для применения в системах памяти ЭВМ в составе гибридных интегральных микросхем, блоков и аппаратуры, обеспечивающих герметизацию и защиту транзисторов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибков, инея и росы, пониженного и повышенного давления.

**Обозначение технических условий**

- аАО.336.152 ТУ



Транзистор КТ624А-2



Транзистор КТ624АМ-2

**Таблица 1. Основные электрические параметры КТ624 при  $T_{\text{окр. среды}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$** 

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	$I_{кбо}$	мкА	$U_{кб}=30\text{В}$	-	100
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером	$h_{21E}$		$U_{CE}=1\text{В}$ $I_{к}=300\text{мА}$ $Q \geq 50$	30	180
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	$U_{кэнас}$	В	$I_{к}=1000\text{мА}$ $I_{б}=100\text{мА}$		0,9
Обратный ток эмиттера	$I_{эбо}$	мА	$U_{эб}=4\text{ В}$	-	100
Время рассасывания	$t_{рас}$	нс	$I_{Б1}=I_{Б2}=100\text{мА}$ $I_{к}=100\text{мА}$		18



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>